

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Kazuto HIROKAWA et al.

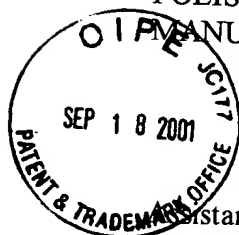
: Docket No. 2001\_1050A

Serial No. 09/910,907

: Group Art Unit 3723

Filed July 24, 2001

POLISHING TOOL AND  
MANUFACTURING METHOD THEREFOR



CLAIM OF PRIORITY UNDER 35 USC 119

Assistant Commissioner for Patents,  
Washington, DC 20231

Sir:

Applicants in the above-entitled application hereby claim the date of priority under the International Convention of Japanese Patent Application No. 2000-224485, filed July 25, 2000, Japanese Application No. 2001-010830, filed January 18, 2001 and Japanese Application No. 2001-125010, filed April 23, 2001, as acknowledged in the Declaration of this application.

Certified copies of said Japanese Patent Applications are submitted herewith.

Respectfully submitted,

Kazuto HIROKAWA et al.

By

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nils E. Pedersen".

Nils E. Pedersen  
Registration No. 33,145  
Attorney for Applicants

NEP/jz  
Washington, D.C. 20006-1021  
Telephone (202) 721-8200  
Facsimile (202) 721-8250  
September 18, 2001

THE COMMISSIONER IS AUTHORIZED  
TO CHARGE ANY DEFICIENCY IN THE  
FEES FOR THIS PAPER TO DEPOSIT  
ACCOUNT NO. 23-0975

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 7月25日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-224485

出 願 人

Applicant(s):

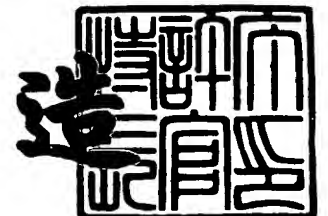
株式会社荏原製作所



2001年 5月25日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3045653

【書類名】 特許願

【整理番号】 EB2194P

【提出日】 平成12年 7月25日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B24D 07/06

【発明者】

    【住所又は居所】 神奈川県藤沢市本藤沢4丁目2番1号 株式会社 荏原  
総合研究所内

    【氏名】 廣川 一人

【発明者】

    【住所又は居所】 神奈川県藤沢市本藤沢4丁目2番1号 株式会社 荏原  
総合研究所内

    【氏名】 桒山 浩国

【発明者】

    【住所又は居所】 神奈川県藤沢市本藤沢4丁目2番1号 株式会社 荏原  
総合研究所内

    【氏名】 和田 雄高

【発明者】

    【住所又は居所】 神奈川県藤沢市本藤沢4丁目2番1号 株式会社 荏原  
総合研究所内

    【氏名】 松尾 尚典

【特許出願人】

    【識別番号】 000000239

    【氏名又は名称】 株式会社 荏原製作所

    【代表者】 依田 正稔

【代理人】

    【識別番号】 100091498

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 渡邊 勇

【選任した代理人】

【識別番号】 100092406

【弁理士】

【氏名又は名称】 堀田 信太郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 026996

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9112447

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書  
 【発明の名称】 研磨工具  
 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 研磨対象物を押圧しつつ摺動することで、砥粒を介して研磨を行う研磨工具において、該研磨工具は熱可塑性樹脂により主として構成されていることを特徴とする研磨工具。

【請求項 2】 研磨対象物を押圧しつつ摺動することで、砥粒を介して研磨を行う研磨工具において、該研磨工具は固さを有するプラスチック樹脂と、該樹脂中に存在する弾性を有する弾性要素とから構成されていることを特徴とする研磨工具。

【請求項 3】 前記研磨工具は、該研磨工具内に砥粒を含み、前記樹脂がバインダ材として該砥粒を保持している研磨用砥石であることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の研磨工具。

【請求項 4】 前記研磨工具は、研磨パッドであることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の研磨工具。

【請求項 5】 前記砥粒が酸化セリウム ( $\text{CeO}_2$ )、アルミナ ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )、炭化珪素 ( $\text{SiC}$ )、酸化珪素 ( $\text{SiO}_2$ )、ジルコニア ( $\text{ZrO}$ )、酸化鉄 ( $\text{FeO}$ 、 $\text{Fe}_3\text{O}_4$ )、酸化マンガン ( $\text{MnO}_2$ 、 $\text{Mn}_2\text{O}_3$ )、酸化マグネシウム ( $\text{MgO}$ )、酸化カルシウム ( $\text{CaO}$ )、酸化バリウム ( $\text{BaO}$ )、酸化亜鉛 ( $\text{ZnO}$ )、炭酸バリウム ( $\text{BaCO}_3$ )、炭酸カルシウム ( $\text{CaCO}_3$ )、ダイヤモンド ( $\text{C}$ )、またはこれらの複合材料で構成されていることを特徴とする請求項 3 に記載の研磨工具。

【請求項 6】 前記研磨工具は、所定の型内に射出成形法で加圧注入することにより成形したものであることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載の研磨工具。

【請求項 7】 前記樹脂が、アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS) 樹脂であることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載の研磨工具。

【請求項 8】 前記弾性要素として弾性体充填材を含み、該弾性体充填材がゴム系充填材であることを特徴とする請求項 2 乃至 5 のいずれかに記載の研磨工

具。

【請求項 9】 前記樹脂に、更に界面活性剤を添加したことを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載の研磨工具。

【請求項 10】 前記樹脂に、更に親水性物質を加えたことを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載の研磨工具。

【請求項 11】 請求項 1 又は 2 に記載の研磨工具を具備したことを特徴とする半導体ウエハの研磨装置。

【請求項 12】 請求項 1 又は 2 に記載の研磨工具を用いて、半導体ウエハを研磨することを特徴とする研磨方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、研磨工具に係り、特に半導体ウエハ等の研磨対象物を平坦かつ鏡面状に研磨する研磨装置に用いる、砥石または研磨パッド等の研磨工具の構成に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、半導体デバイスの高集積化が進むにつれて、回路の配線が微細化し、集積されるデバイスの寸法もより微細化されつつある。そこで、半導体ウエハの表面に形成された被膜を研磨により除去して、表面を平坦化する工程が必要となる場合があるが、この平坦化法の手法として、化学・機械研磨（CMP）装置により研磨することが行われている。この種の化学・機械研磨（CMP）装置は、研磨布（パッド）を貼ったターンテーブルとトップリングとを有し、ターンテーブルとトップリングとの間に研磨対象物を介在させて、トップリングが一定の圧力をターンテーブルに与えつつ両者が回転し、研磨布に砥液（スラリ）を供給しつつ研磨対象物の表面を平坦かつ鏡面状に研磨している。

【0003】

このような砥液（スラリ）を用いた化学・機械研磨（CMP）においては、比較的軟らかな研磨布に研磨砥粒を多量に含む砥液（スラリ）を供給しつつ研磨す

るので、パターン依存性に問題がある。パターン依存性とは研磨前に存在する半導体ウエハ上の凹凸パターンにより研磨後にもその凹凸に起因した緩やかな凹凸が形成され、完全な平坦度が得られにくいことである。即ち、細かなピッチの凹凸の部分は研磨速度が早く、大きなピッチの凹凸の部分は研磨速度が遅くなり、これにより研磨速度の早い部分と研磨速度の遅い部分とで緩やかな凹凸が形成されるという問題である。また、研磨布（パッド）による研磨では、凹凸の凸部のみならず凹部も共に研磨されるため、凸部のみが研磨されて完全に平坦となった状態で研磨が停止するいわゆるセルフストップ機能は実現することが困難であった。

## 【 0 0 0 4 】

一方で、酸化セリウム（ $\text{CeO}_2$ ）等の砥粒を例えばフェノール樹脂等のバインダを用いて固定した、いわゆる固定砥粒（砥石）を用いた半導体ウエハの研磨が研究されている。このような砥石による研磨では、研磨材が従来の化学機械研磨と異なり硬質であるため、凹凸の凸部を優先的に研磨し、凹部は研磨され難いため、絶対的な平坦性が得やすいという利点がある。また、砥石の組成によっては、凸部の研磨が終了し平坦面となると研磨速度が著しく低下し、研磨が事実上進行しなくなるいわゆるセルフストップ機能が現れる。また、砥石を用いた研磨では砥粒を多量に含む研濁液（スラリー）を使用しないため、環境問題の負荷が低減するという利点もある。

## 【 0 0 0 5 】

しかしながら、砥石を用いた研磨では、以下に述べる問題点がある。即ち、半導体デバイスを製作する上で化学・機械研磨（CMP）後の半導体ウエハ研磨面は、高平坦性を実現すると共にスクラッチ（キズ）の発生を防ぐ必要がある。一般的な化学・機械研磨（CMP）用研磨パッドによる研磨では、パッドの硬度が高い場合に研磨面にスクラッチが生じやすいことが知られており、そのためパッド材料には柔らかい発泡剤が使用されている。一方で、半導体研磨用砥石では前記パッドより硬い材料を用いるため、研磨面の高い平坦性が実現できる反面、研磨面に多くのスクラッチが発生しやすい。

## 【 0 0 0 6 】

従って、半導体研磨用砥石は、非常に限られたバインダ種類や、砥粒、バインダ、気孔の組成比のバランスが取れた比較的狭い範囲で使用されてきた。一方、研磨の対象は、シリコン基板、ポリシリコン膜、酸化膜、窒化膜、アルミまたは銅材からなる配線層等と多岐にわたる。このため、これらの各種の研磨対象に応じて、研磨速度の安定性、及び良好な段差特性を有すると共に、スクラッチ（キズ）の発生しにくい研磨用砥石を製作することは、事実上困難であった。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上述した事情に鑑みて為されたもので、研磨速度の安定性、良好な段差特性が得られると共に、半導体ウェハの研磨対象物の研磨面に発生する欠陥（スクラッチ）の低減等を各種の研磨対象物に対して良好に発揮できる研磨工具を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、研磨対象物を押圧しつつ摺動することで、砥粒を介して研磨を行う研磨工具において、該研磨工具は熱可塑性樹脂により主として構成されていることを特徴とする研磨工具である。

【0009】

請求項2に記載の発明は、研磨対象物を押圧しつつ摺動することで、砥粒を介して研磨を行う研磨工具において、該研磨工具は弾性係数  $1000 \text{ kgf/cm}^2$  ( $9800 \text{ N/cm}^2$ ) 以上のプラスチック樹脂と、該樹脂中に存在するショア硬さ5～60程度又は弾性係数  $500 \text{ kgf/cm}^2$  ( $4900 \text{ N/cm}^2$ ) 以下である弾性を有する弾性要素とから構成されていることを特徴とする研磨工具である。

【0010】

請求項3に記載の発明は、前記研磨工具は、該研磨工具内に砥粒を含み、前記樹脂がバインダ材として該砥粒を保持している研磨用砥石であることを特徴とする請求項1または2に記載の研磨工具である。

【0011】



請求項 4 に記載の発明は、前記研磨工具は、研磨パッドであることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の研磨工具である。

#### 【 0 0 1 2 】

これまで半導体ウェハ等の研磨用砥石は、PVA やフェノール樹脂、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂が一般に広く用いられてきた。本発明では、熱硬化性樹脂に代えて熱可塑性樹脂を用いること、また、固さを有するプラスチック材中に弾性要素を有する樹脂を用いることにより、後述するように従来の研磨用砥石では得られなかった様々な特性の砥石を得ることができる。即ち、半導体ウェハ等の研磨においては研磨中に発熱が生じるので、研磨用砥石または研磨パッドに熱可塑性樹脂を用いることで、研磨中に当該樹脂が発熱により軟らかくなる。これにより軟らかな研磨面による研磨が可能となり、スクラッチ（キズ）の発生が抑えられる。また、樹脂中に弾性要素を含む硬い樹脂を用いることで、マクロ的に見れば硬く、ミクロ的に見れば軟らかな研磨面が得られ、これにより平坦特性に優れると共にスクラッチ（キズ）の発生の少ない高品位の研磨が行える。

#### 【 0 0 1 3 】

請求項 5 に記載の発明は、砥粒が酸化セリウム ( $\text{CeO}_2$ )、アルミナ ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )、炭化珪素 ( $\text{SiC}$ )、酸化珪素 ( $\text{SiO}_2$ )、ジルコニア ( $\text{ZrO}$ )、酸化鉄 ( $\text{FeO}$ 、 $\text{Fe}_3\text{O}_4$ )、酸化マンガン ( $\text{MnO}_2$ 、 $\text{Mn}_2\text{O}_3$ )、酸化マグネシウム ( $\text{MgO}$ )、酸化カルシウム ( $\text{CaO}$ )、酸化バリウム ( $\text{BaO}$ )、酸化亜鉛 ( $\text{ZnO}$ )、炭酸バリウム ( $\text{BaCO}_3$ )、炭酸カルシウム ( $\text{CaCO}_3$ )、ダイヤモンド ( $\text{C}$ )、またはこれらの複合材料で構成されていることを特徴とする研磨用砥石である。

#### 【 0 0 1 4 】

これにより比較的入手が容易な原料を用いて、研磨速度安定性、段差特性に優れ、且つスクラッチ（キズ）の発生の少ない研磨を実現可能な砥石を提供できる。

#### 【 0 0 1 5 】

請求項 6 に記載の発明は、射出成形法（インジェクション）で成形したことを特徴とする研磨用砥石または研磨用パッドである。射出成形とは、加熱して流動

状態にした原材料を、閉じた金型の空洞部（キャビティ）に加圧注入し、金型内で固化させることにより、金型空洞部に相当する成形品を造る方法である。これにより、容易に、且つ良好な量産性で研磨用砥石等を製造することができる。

## 【 0 0 1 6 】

請求項 7 に記載の発明は、樹脂がアクリロニトリルブタジエンスチレン（以下、ABS と言う）樹脂であることを特徴とする研磨用砥石または研磨用パッドである。ABS 樹脂は、アクリロニトリル、ブタジエン、スチレンの共重合物である。小さく柔らかなブタジエンゴムの核に硬い AS（アクリロニトリルスチレン）樹脂が絡んだ構造をしている。これにより、ABS 樹脂で構成した研磨用砥石は、研磨作用面はマクロ的に見れば AS 樹脂と同等に硬く、研磨時には研磨対象の高平坦性が得られ、ミクロ的に見れば、柔らかなブタジエンゴムによる衝撃吸収作用が働き、スクラッチ（キズ）の発生が押さえられ、高品位の研磨が実現可能となる。また、ABS 樹脂で構成した研磨用パッドは、研磨作用面はマクロ的に見れば AS 樹脂と同等に硬く、ミクロ的に見れば、柔らかなブタジエンゴムによる衝撃吸収作用が働くので、同様に高品位の研磨が実現可能となる。

## 【 0 0 1 7 】

請求項 8 に記載の発明は、前記樹脂に更に弾性体充填材を含み、該弾性体充填材がゴム系充填材であることを特徴とする研磨工具である。これにより、研磨工具の構成材料として小さく柔らかなゴム粒子を含むことにより、上記 ABS 樹脂と同様のマクロ的に見れば硬く、ミクロ的に見れば軟らかな効果が得られ、高品位の研磨が実現可能となる。従って、外部より砥粒を含むスラリを供給しながら、研磨する場合にも、スクラッチ（キズ）の少ない高品位の研磨を実現できる。

## 【 0 0 1 8 】

請求項 9 に記載の発明は、構成材料に界面活性剤を添加したことを特徴とする研磨用砥石または研磨用パッドである。一般に砥石において砥粒を固定するバインダに用いる高分子材料（樹脂）は、砥粒との濡れ性が悪く、そのため、砥粒とバインダのみで成形した場合、砥粒が均一に分散せず、大きな砥粒塊が成形体中に存在してしまうという問題がある。極く小さい砥粒塊は研磨時に脱落し、研磨副生成物や研磨クズを捕集するポケットとして機能すると言われており、研磨に

対し有用であると考えられる。しかしながら、大きな数百nmオーダーの砥粒塊は、研磨時に該砥粒塊がすぐに砥石から離脱してしまい、研磨能力の経時変化が大きく、すぐに研磨能力が低下してしまう。さらに、砥石面内で研磨能力に差が生じてしまい、研磨むらが生じてしまうなど研磨阻害要因となる。そのため、原料混練時に界面活性剤を利用し、砥粒とバインダの濡れ性を確保し、砥粒を均一に分散させることで、安定した研磨を可能とする砥石を製作することができる。

## 【0019】

請求項10に記載の発明は、前記樹脂に、更に親水性物質を加えたことを特徴とする研磨パッドである。一般に、高分子材料は、疎水性を示し、研磨液をはじいてしまうため、研磨液保持能力が低く、安定した研磨を行うことが難しいという問題がある。そのため、表面に親水基を多く持つ親水性物質をパッドに含有することにより親水性を確保し、これにより表面にむら無く研磨液を保持することが可能となり、安定した研磨を行うことができる。

## 【0020】

請求項11に記載の発明は、請求項1又は2に記載の研磨工具を具備したことを特徴とする半導体ウエハの研磨装置である。

## 【0021】

請求項12に記載の発明は、請求項1又は2に記載の研磨工具を用いて、半導体ウエハを研磨することを特徴とする研磨方法である。

## 【0022】

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照しながら説明する。

## 【0023】

図1は、本発明の実施形態の研磨用砥石を模式的に示す。(a)に示す砥石1は、砥粒5、気孔または気孔剤2とがバインダ(樹脂)4により結合して構成されている。ここで、バインダ4としてABS樹脂等の熱可塑性樹脂を用いる。これにより、温度を上昇させるとバインダが軟化し、弾力性を有する状態となり、ゴム系樹脂と同等な作用を為し、研磨に際して軟らかく研磨対象物の被研磨面に接触することでスクラッチ等を低減して研磨を行うことができる。(b)に示す

砥石 1 は、砥粒 5、ゴム系粒子等の弾性体充填材 3、気孔または気孔剤 2 とがバインダ（樹脂） 4 により結合して構成されている。ここで、バインダ 4 としては硬い樹脂を用いている。弾性体充填材 3 は、ゴム系粒子と同等な作用を為し、研磨に際して軟らかく研磨対象物の被研磨面に接触することでスクラッチ等を低減して研磨を行うことができる。

## 【 0 0 2 4 】

従来の砥石は、砥粒を含むバインダ混合原料を圧縮成形で成形することが一般的であった。これに対して本発明の砥石は熱可塑性樹脂を使用することを特徴としたものであり、これにより、射出成形やブロー成形、真空成形などにより量産効果の大きい砥石の製作が可能となる。熱可塑性樹脂は種類が多く、今までにない様々な特性の砥石を製作することが可能となり、種々の研磨対象に好適な研磨特性を有する砥石を製作することができる。即ち、熱可塑性樹脂はある温度以上になると溶解する特徴を有する。研磨対象物に対し、好適な熱可塑性樹脂を主成分とした砥石を選定することにより、研磨の際には局所的に高温になると考えられ、砥石の研磨作用部では、軟化し粘性を有することになる。このため、砥粒による研磨面への加工圧力を安定させることができ、砥粒に過度な加工力がかかることがない。すなわち、軟らかな工具で砥粒を押さえつけることになり、研磨後の研磨対象物表面のスクラッチ（キズ）を低減できる。

## 【 0 0 2 5 】

以下に、熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂の構成材料例を示す。熱硬化性樹脂には、フェノール P F、ユリア U F、メラミン M F、不飽和ポリエステル U P、エポキシ E P、シリコーン S I、ポリウレタン P U R 等がある。また、熱可塑性樹脂には、汎用プラスチックとして知られるポリ塩化ビニル（P V C）、ポリエチレン（P C）、ポリプロピレン（P P）、ポリスチレン（P S）、A B S、A S A S、ポリメチルメタアクリル（P M M A）、ポリビニールアルコール（P V A）、ポリ塩化ビニリデン（P V D C）、ポリエチレンテレフタレート（P E T）、エンジニアリングプラスチックとして知られるポリアミド（P A）、ポリアセタール（P O M）、ポリカーボネート（P C）、ポリフェニレンエーテル（P P E（変性 P P O））、ポリブチレンテレフタレート（P B T）、超高分子量ポリエ

チレン (UHMW-PE)、ポリ弗化ビニリデン (PVDF)、スーパーエンジニアリングプラスチックとして知られているポリサルホン (PSF)、ポリエーテルサルホン (PES)、ポリフェニレンサルファイド (PPS)、ポリアリレート (PAR)、ポリアミドイミド (PAI)、ポリエーテルイミド (PEI)、ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)、ポリイミド (PI)、液晶ポリマー (LCP)、ポリテトラフロロエチレン (PTFE) がある。

## 【0026】

図2は、射出成形器を模式的に示す。この射出成形器は、シリンダ16内のシリンダ室16aに保持された液状材料を金型15内に射出成形するための加圧ヘッド19を備えている。スクリュー17はスクリュー回転用油圧モータ12により回転することで投入口18より投入された樹脂材料を加圧ヘッド19の前のシリンダ室内の空間16に押圧移動する。シリンダ16の周面にはヒータ13が配置され、投入された固形の樹脂材料をスクリュー17で移動中に加温し、樹脂の融点以上にすることにより、液状材料に変換する。そして、射出油圧駆動機11により加圧ヘッド19を金型15側に押圧移動することにより、液状樹脂が金型15内の空隙部15aに充填される。

## 【0027】

即ち、主に砥粒と樹脂を混練した材料は材料投入口18より投入され、スクリュー17を回転させることにより、供給部18から射出部16aへと送られる。その際、材料はヒータ13により加熱され、溶解し、液状となる。加圧ヘッド19を往復動作することにより、液状材料は、金型15の空隙部15aへと射出され、製品形状となる。その後、冷却、離型し、製品となる。射出成形用樹脂には、塩化ビニル樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ポリスチレンメタアクリル樹脂、ポリカーボネイト酢酸セルロース、ポリアセタールポリアミド、ポリプロピレン、ポリエチレン、3フッ化エチレン樹脂、フッ化ビニリデン樹脂、等の熱可塑性樹脂全般、及びフェノール樹脂、ポリエステル樹脂、ジアリルフタレートなどの一部の熱硬化性樹脂を用いることができ、様々な樹脂の成形が可能となる。また、一度に多数の成形品が製造可能となり、圧縮成形と比較し加工工程が少なく、製作時間が短縮でき、複雑な形状でも精度よく製造することができるばかりでなく、

高能率で量産化が容易になる。

【 0 0 2 8 】

特にバインダとしてABS樹脂を用いれば、温度上昇時に熱可塑性樹脂による軟らかな研磨が行なえると同時に、ABS樹脂はブタジエンゴムの核にAS樹脂が絡んだ構造をしているため、研磨時に発生する温度が樹脂の軟化温度より低い場合にも、スクラッチ（キズ）の少ない研磨が可能であり、高品位のウエハ平坦化加工が可能となる。即ち、ABS樹脂は、その組成自体が弾性要素を本質的に備えており、マクロ的に見ればAS樹脂と同等に硬く、研磨時には研磨対象の高平坦性が得られ、ミクロ的に見れば、柔らかなブタジエンゴムによる衝撃吸収作用が働き、スクラッチ（キズ）の発生が押さえられる。尚、ABS樹脂以外にも、樹脂構造に弾性体が入り込んだ構造をしているものとして、塩化ビニルにブタジエン・スチレン、メタクリレート（MBS）を改質剤として加えたものが挙げられる。これにより弾性要素として、MBSを作用させることができ、同様にマクロ的に見れば硬く、研磨時には研磨対象の高平坦性が得られ、ミクロ的に見れば、柔らかな弾性要素による衝撃吸収作用を得ることができる。

【 0 0 2 9 】

図1（b）に示すように、砥粒とバインダ（プラスチック材料）の他に微細ゴム粒子を混練し、成形してもABS樹脂の効果と同等の効果が得られる。プラスチック材料中に添加するゴム系粒子の具体例としては、天然ゴム（IR）、スチレンブタジエン（SBR）、ブタジエン（BR）、クロロプレン（CR）、ブチル（IIR）、ニトリル（NBR）、エチレンプロピレン（EPM, EPDM）、クロロスルホン化ポリスチレン（CSM）、アクリルゴム（アクリル酸アルキルエステルと架橋性モノマとの共重合性体ACM、アクリル酸アルキルエステルとアクリロニトリルとの共重合体ANM）、ウレタンゴムU、シリコンゴムQ、フッ素ゴムFKM、多硫化ゴムT等が上げられ、特にクロロスルホン化ポリスチレン（CSM）は耐候性、耐酸性、耐無機薬品性、耐摩耗性に優れ、アクリルゴム（アクリル酸アルキルエステルと架橋性モノマとの共重合性体ACMや、アクリル酸アルキルエステルとアクリロニトリルとの共重合体ANM）は耐熱性に優れ、フッ素ゴム（FKM）は耐熱性、耐薬品性、耐候性に優れ、シリコンゴムQ

は耐熱性に優れるばかりでなく、使用温度範囲が広範囲であり、研磨環境に対し、変質しづらく、非常に好適である。

#### 【0030】

また、ゴム系粒子以外に弾性体中空粒子も同様にして有効である。例えば、ポリアクリロニトリル（PAN）等の中空粒子を用いてもよい。

#### 【0031】

ところで、高品位の研磨を行うためには、砥石作用面内で研磨効率を一定にする必要があり、そのため砥粒の分布を均一にする必要がある。多くの樹脂は高分子材料であり、金属酸化物である砥粒との濡れ性が悪く、砥粒は砥石組織内に大きな塊状粒子として存在する傾向がある。例えば、砥粒に酸化セリウム微細粒子、バインダにABS樹脂を用いた場合、砥粒との濡れ性が悪く、成形品中に砥粒が数mmから数百nmオーダーの砥粒塊が存在する傾向がある。界面活性剤を添加することでこれを改善でき、高品位の研磨が可能となる。均一分散の方法は界面活性剤の利用以外に、成形前に十分な時間をかけ練り込むことが考えられるが、時間がかかり、効率的でない。界面活性剤を使用すれば、表面張力を下げられ、均一分散が可能となる。例えば、ユリア系樹脂に非イオン活性剤を0.01～0.2%添加することにより、表面張力は約63から約50dyne/cmに下がることが知られている。

#### 【0032】

上述の説明は研磨用の砥石の構成例についてのものであるが、上述した構成例は研磨用砥粒を多量に含む砥液（スラリー）を用いて半導体ウエハ等を研磨する場合に用いられる研磨パッドにも同様に適用可能である。研磨パッドとして、より高硬度な樹脂を用いた場合、研磨面の平坦性が得られるが、研磨時に多くのスクラッチ（キズ）を生じ易い。そこで、図3（a）に示すように、研磨パッドを硬質の樹脂42で形成すると共に、その組成内に小さく軟らかなゴム粒子41を入れることにより、スクラッチ（キズ）の発生を防止できる。

#### 【0033】

使用するゴムの具体例としては、砥石の場合と同様に、天然ゴム（IR）、スチレンブタジエン（SBR）、ブタジエン（BR）、クロロプレン（CR）、ブ

チル (IIR)、ニトリル (NBR)、エチレンプロピレン (EPM, EPDM)、クロロスルホン化ポリスチレン (CSM)、アクリルゴム (アクリル酸アルキルエステルと架橋性モノマとの共重合性体 ACM、アクリル酸アルキルエステルとアクリロニトリルとの共重合体 ANM)、ウレタンゴム U、シリコンゴム Q、フッ素ゴム FKM、多硫化 T 等を用いることができる。特に、クロロスルホン化ポリスチレン (CSM) は耐候性、耐酸性、耐無機薬品性、耐摩耗性に優れ、アクリルゴム (アクリル酸アルキルエステルと架橋性モノマとの共重合性体 ACM や、アクリル酸アルキルエステルとアクリロニトリルとの共重合体 ANM) は耐熱性に優れ、フッ素ゴム FKM は耐熱性、耐薬品性、耐候性に優れ、シリコンゴム Q は耐熱性に優れるばかりでなく、使用温度範囲が広範囲であり、研磨環境に対し、変質しづらく、非常に好適である。また、ゴム粒子以外に弾性体中空粒子も同様にして有効である。例えば、ポリアクリロニトリル (PAN) 等の中空粒子を用いることができる。樹脂材料は上述の砥石に用いられた材料と同様な材料が用いられる。

## 【 0 0 3 4 】

図 3 (b) は、研磨パッドに ABS 樹脂を用いた場合を示す。研磨パッドに ABS 樹脂 51 を用いれば、ABS 樹脂はマクロ的には硬度の高い樹脂であるが、その組成に小さく軟らかなブタジエンゴム 52 を含んでいる。これにより、研磨作用面はマクロ的に見ればアクリロニトリルスチレン (AS:SAN) 樹脂と同等に硬く、研磨時には研磨対象の高平坦性を得られ、ミクロ的に見れば、軟らかなブタジエンゴムによる研磨砥粒の衝撃吸収作用が働き、スクラッチ (キズ) の発生が押さえられ、高品位の研磨が実現可能となる。

## 【 0 0 3 5 】

ところで、一般に樹脂材料は疎水性を示すため、研磨時にパッド表面に研磨砥液 (スラリ) を保持し難い。そのため、安定な研磨を行うためには、ドレッシング (シーズニング) と呼ばれる工程が必要となる。即ち、ダイヤモンドヤスリでパッド表面を薄く削り、研磨クズを排除すると共に表面を毛羽立てることにより、表面積を増やし、スラリを保持しやすくする工程である。パッド自身が親水性を示す場合、表面積を増やすための余分なドレッシング工程が必要なくなり、研



磨クズを除去するのみですむため、パッドのドレス代が少なくなり、長期の使用が可能となる。親水性を示す材料には、 $-\text{CO}-\text{OH}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{NHCONH}_2$ 、 $-(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n-$ などの親水基を持つ材料すべてが対象となる。また、一般に酸素、窒素、硫黄などの元素を含む基は親水基であり、特に塩を作っている場合には強親水性基となり、非常に好適である。強親水性基には、 $-\text{SO}_3\text{H}$ 、 $-\text{SO}_3\text{M}$ 、 $-\text{OSO}_3\text{H}$ 、 $-\text{OSO}_3\text{M}$ 、 $-\text{COOM}$ 、 $-\text{NR}_3\text{X}$ （ $\text{M}$ ：アルカリ金属または $-\text{NH}_4$   $\text{R}$ ：アルキル基、 $\text{X}$ ：ハロゲン）等がある。研磨パッドを構成する樹脂に、上記親水性物質を加えることにより、研磨時にパッド表面にスラリを容易に保持することができる研磨パッドが得られる。

## 【 0 0 3 6 】

図4は本発明の実施形態に係る主として半導体ウエハを研磨するためのポリッシング装置の各部の配置構成を示す平面図である。このポリッシング装置には、本発明の上述した研磨用砥石又は研磨用パッドが用いられている。

図4に示すポリッシング装置は多数の半導体ウエハをストックするウエハカセット21を載置するロードアンロードステージ22を4つ備えている。ロードアンロードステージ22は昇降可能な機構を有していても良い。ロードアンロードステージ22上の各ウエハカセット21に到達可能となるように、走行機構23の上に2つのハンドを有した搬送ロボット24が配置されている。

## 【 0 0 3 7 】

前記搬送ロボット24における2つのハンドのうち下側のハンドはウエハカセット21より半導体ウエハを受け取るときのみに使用され、上側のハンドはウエハカセット21に半導体ウエハを戻すときのみに使用される。これは、洗浄した後のクリーンなウエハを上側にして、それ以上ウエハを汚さないための配置である。下側のハンドはウエハを真空吸着する吸着型ハンドであり、上側のハンドはウエハの周縁部を保持する落とし込み型ハンドである。吸着型ハンドはカセット内のウエハのずれに関係なく正確に搬送し、落とし込み型ハンドは真空吸着のようにごみを集めてこないののでウエハの裏面のクリーン度を保って搬送できる。搬送ロボット24の走行機構3を対称軸に、ウエハカセット21とは反対側に2台の洗浄機25、26が配置されている。各洗浄機25、26は搬送ロボット24のハ

ンドが到達可能な位置に配置されている。また2台の洗浄機25, 26の間で、ロボット24が到達可能な位置に、4つの半導体ウエハの載置台27, 28, 29, 30を備えたウエハステーション70が配置されている。前記洗浄機25, 26は、ウエハを高速回転させて乾燥させるスピンドライ機能を有しており、これによりウエハの2段洗浄及び3段洗浄にモジュール交換することなく対応することができる。

## 【0038】

前記洗浄機25, 26と載置台27, 28, 29, 30が配置されている領域Bと前記ウエハカセット21と搬送ロボット4が配置されている領域Aのクリーン度を分けるために隔壁34が配置され、互いの領域の間で半導体ウエハを搬送するための隔壁の開口部にシャッター31が設けられている。洗浄機25と3つの載置台27, 29, 30に到達可能な位置に2つのハンドを有した搬送ロボット40が配置されており、洗浄機26と3つの載置台28, 29, 30に到達可能な位置に2つのハンドを有した搬送ロボット41が配置されている。

## 【0039】

前記載置台27は、搬送ロボット24と搬送ロボット40との間で半導体ウエハを互いに受渡すために使用され、半導体ウエハの有無検知用センサ91を具備している。載置台28は、搬送ロボット24と搬送ロボット41との間で半導体ウエハを受渡すために使用され、半導体ウエハの有無検知用センサ92を具備する。載置台29は、搬送ロボット41から搬送ロボット40へ半導体ウエハを搬送するために使用され、半導体ウエハの有無検知用センサ93と半導体ウエハの乾燥防止、もしくは洗浄用のリンスノズル95を具備している。載置台30は、搬送ロボット40から搬送ロボット41へ半導体ウエハを搬送するために使用され、半導体ウエハの有無検知用センサ94と半導体ウエハの乾燥防止、もしくは洗浄用のリンスノズル96を具備している。載置台29及び30は共通の防水カバーの中に配置されていて、搬送用のカバー開口部にはシャッター97を設けている。載置台29は載置台30の上にあり、洗浄後のウエハを載置台29に、洗浄前のウエハを載置台30に置くことにより、リンス水の落下による汚染を防止している。なお、図4においては、センサ91, 92, 93, 94、リンスノズ

ル 9 5, 9 6、およびシャッター 9 7 は模式的に示したものであって、位置および形状は正確に図示されていない。

#### 【 0 0 4 0 】

前記搬送ロボット 4 0 および搬送ロボット 4 1 の上側のハンドは、一度洗浄された半導体ウエハを洗浄機もしくはウエハステーション 7 0 の載置台へ搬送するのに使用され、下側のハンドは 1 度も洗浄されていない半導体ウエハ、及び研磨される前の半導体ウエハを搬送するのに使用される。下側のハンドで反転機へのウエハの出し入れを行うことにより、反転機上部の壁からのリンス水のしずくにより上側のハンドを汚染することがない。

前記洗浄機 2 5 と隣接するように搬送ロボット 4 0 のハンドが到達可能な位置に洗浄機 4 2 が配置されている。また、洗浄機 2 6 と隣接するように搬送ロボット 4 1 のハンドが到達可能な位置に洗浄機 4 3 が配置されている。

前記洗浄機 2 5, 2 6, 4 2, 4 3 とウエハステーション 7 0 の載置台 2 7, 2 8, 2 9, 3 0 と搬送ロボット 4 0, 4 1 は全て領域 B の中に配置されていて、領域 A 内の気圧よりも低い気圧に調整されている。前記洗浄機 4 2, 4 3 は、両面洗浄可能な洗浄機である。

#### 【 0 0 4 1 】

本ポリッシング装置は、各機器を囲むようにハウジング 6 6 を有しており、前記ハウジング 6 6 内は隔壁 3 4、隔壁 3 5、隔壁 3 6、隔壁 4 4、および隔壁 6 7 により複数の部屋（領域 A、領域 B を含む）に区画されている。

隔壁 4 4 によって領域 B と区分されたポリッシング室が形成され、ポリッシング室は更に隔壁 6 7 によって 2 つの領域 C と D に区分されている。そして、2 つの領域 C, D にはそれぞれ 2 つの研磨テーブルと、1 枚の半導体ウエハを保持しかつ半導体ウエハを前記研磨テーブルに対して押し付けながら研磨するための 1 つのトップリングが配置されている。即ち、領域 C には研磨テーブル 5 4, 5 6、領域 D には研磨テーブル 5 5, 5 7 がそれぞれ配置されており、また、領域 C にはトップリング 5 2、領域 D にはトップリング 5 3 がそれぞれ配置されている。また領域 C 内の研磨テーブル 3 4 に研磨砥液を供給するための砥液ノズル 6 0 と、研磨テーブル 5 4 のドレッシングを行うためのドレッサ 5 8 とが配置されて

いる。領域D内の研磨テーブル55に研磨砥液を供給するための砥液ノズル61と、研磨テーブル55のドレッシングを行うためのドレッサ59とが配置されている。さらに、領域C内の研磨テーブル56のドレッシングを行うためのドレッサと、領域D内の研磨テーブル57のドレッシングを行うためのドレッサ69とが配置されている。なお、研磨テーブル56、57の替わりに、湿式タイプのウエハ膜厚測定機を設置してもよい。その場合は、研磨直後のウエハの膜厚を測定することができ、ウエハの削り増しや、測定値を利用して次のウエハへの研磨プロセスの制御を行うこともできる。

#### 【0042】

前記トップリング52および53に移送されたウエハは、トップリングの真空吸着機構により吸着され、ウエハは研磨テーブル54または55まで吸着されたまま搬送される。そして、ウエハは研磨テーブル54、55上に取り付けられた研磨パッド又は砥石等からなる研磨面で研磨される。トップリング52及び53がそれぞれに到達可能な位置に、前述した第2の研磨テーブル56と57が配置されている。これにより、ウエハは第1の研磨テーブル54、55で研磨が終了した後、第2の研磨テーブル36、37で研磨できるようになっている。しかしながら、半導体ウエハに付けられた膜種によっては、第2の研磨テーブル56、57で研磨された後、第1の研磨テーブル54、55で処理されることもある。この場合、第2の研磨テーブルの研磨面が小径であることから、研磨パッドに比べて値段の高い砥石を張り付け、粗削りをした後に、大径の第1の研磨テーブルに寿命が砥石に比べて短い研磨パッドを貼り付けて仕上げ研磨をすることで、ランニングコストを低減することが可能である。このように、第1の研磨テーブルを研磨パッド、第2の研磨テーブルを砥石とすることにより、安価な研磨テーブルを供給できる。というのは、砥石の価格は研磨パッドより高く、径にほぼ比例して高くなる。また、砥石より研磨パッドの方が寿命が短いので、仕上げ研磨のように軽荷重で行った方が寿命が延びる。また、径が大きいと接触頻度が分散でき、寿命が延びる。よって、メンテナンス周期が延び、生産性が向上する。

#### 【0043】

図5は、ポリッシング装置の要部を示す図である。このポリッシング装置は、

表面に研磨パッドに代わり直径約60cmの砥石115を円盤116に貼設した砥石工具117を装着した研磨テーブル56(57)と、研磨中に砥粒を含まない水又は薬液Wを供給する液供給ノズル110とを備えている。ここで砥石工具117は、本発明の例えばABS樹脂からなる熱可塑性樹脂により主として構成されている砥石115を金属又はセラミックスの円盤116に接着剤を用いて固着したものである。そして、砥石工具117は、研磨テーブル56(57)にクランプ機構118、119を用いて簡単、且つ確実に固定されている。ウエハ研磨条件は例えば、「ウエハ面圧： $300\text{ g/cm}^2$  ( $2940\text{ N/cm}^2$ )、回転数：テーブル／ウエハ＝ $30/35\text{ min}^{-1}$ 、液体供給量： $200\text{ cc/min}$ 、液体種類：純水(1wt%以下の界面活性剤含有)」である。

## 【0044】

その他の研磨対象物104を保持するトップリング101等の構成は、他の研磨テーブル54、55と同様である。ここで砥石115の研磨面上に水等を供給するのは、研磨の際の研磨面の潤滑と研磨によって生じる熱を除去する冷却のためである。一例として、この場合には $200\text{ ml/min}$ 程度の水を供給している。水は不純物を含まない超純水を使用してもよい。尚、水に代えてアルカリ溶液等を用いるようにしてもよい。

## 【0045】

研磨対象物である半導体ウエハ104は、トップリング101により弾性マット102を介して砥石115上に押圧されつつ、駆動軸108により回転駆動される。一方で、砥石115を固定した研磨テーブル56(57)も独立に回転駆動され、ここで半導体ウエハ104の被研磨面が砥石115の表面と接触し、摺動することにより研磨が進行する。

## 【0046】

次に、砥石を貼着した砥石工具を、回転定盤に固定する具体例を示す。

図6は、クランプ方式により砥石工具を定盤に固定することを示す。砥石115はアルミ材等からなる金属円盤116に貼着により固定され、砥石工具117を構成している。研磨テーブル56(57)にはクランプ機構118を備え、このクランプ機構118の可動部119が砥石工具117の外周部を固定するよう

になっている。従って、可動部 119 を開いた状態にして砥石 115 を貼着した砥石工具 117 を研磨テーブル 56 (57) 上に載せ、可動部 119 を閉じることにより、可動部のばね機構により砥石工具 117 を研磨テーブル 56 (57) に固定できる。又、可動部 119 が閉じた位置から可動部 119 を開いた位置に回転することにより、砥石工具 117 を研磨テーブル 56 (57) から取り外すことができる。

## 【0047】

図 7 は、砥石工具を定盤に固定する他の固定方法を示す。砥石 115 はアルミ材等からなるつば付きの金属円盤 116 に貼着により固定され、砥石工具 117 を構成している。砥石工具 117 はそのつば部 117 A が研磨テーブル 56 (57) にクランプ 132 のボルト締結により固定される。即ち、図示するように 4 個のクランプを用いて、それぞれのクランプ 132 がボルト 133 により研磨テーブル 56 (57) に設けられたネジ孔に対して砥石工具 117 のつば部 117 A を締結することにより固定される。クランプ 132 は、図示するように比較的幅広の円弧状の構造のものをを用い、円弧の両端部の中心に対してなす角度は、 $44^{\circ}$  に設定して、2 個のボルトを用いて砥石工具 117 のつば部 117 A を研磨テーブル 56 (57) の表面に挟み込むことで固定する。従って、砥石工具 117 の研磨テーブル 56 (57) への脱着は、ボルト 133 の脱着により容易に行うことができる。尚、このように比較的幅広のクランプを用いるのは、そのクランプにより砥石工具 117 の外周部を研磨テーブル 56 (57) に固定するので、砥石 115 の研磨面に押しつけによるたわみが出ないようにするためである。

## 【0048】

又、砥石工具 117 を構成する金属円盤のつば部 117 A の外周部に突起部 135 が合計 4 カ所配設されている。そして各突起部 135 にはネジ孔 136 が設けられており、吊りボルト又は押しボルト 137 が締結できるようになっている。吊りボルト 137 は、砥石工具 117 の交換等に際して、砥石工具 117 がかなりの重量を有するため、そのハンドリングを容易にするために設けたものである。又、ネジ孔 136 は、研磨テーブル 56 (57) に密着している砥石工具 117 を剥がすために、押しボルト 137 を挿入するためのものでもある。即ち、

砥石工具 1 1 7 を密着した研磨テーブル 5 6 ( 5 7 ) から剥がすに際して、押しボルト 1 3 7 をネジ孔 1 3 6 に挿入して回転することにより、押しボルト 1 3 7 の先端が回転定盤の表面に当接し、更に回転することにより、砥石工具 1 1 7 を研磨テーブル 5 6 ( 5 7 ) から剥がすことができる。尚、研磨テーブル 5 6 ( 5 7 ) のネジ孔 1 3 6 に対する位置に溝 1 3 8 が形成されている。溝 1 3 8 は吊りボルト又は押しボルト 1 3 7 の先端を受け入れる役割を果たす。

## 【 0 0 4 9 】

尚、この実施例ではクランプ 1 3 2 を 4 個、突起部 1 3 5 を 4 個それぞれ配設しているが、押し付け加重等の使用条件を考慮して、クランプをリング状に構成して砥石工具の全周を固定するようにしても良い。又、突起部の数も、砥石工具の重量や定盤との密着力を考慮して適宜配設数を増減しても良い。尚、砥石を貼着する金属円盤の材料としては、アルミ材以外にも耐食性を考慮し例えばステンレス材やチタン等を用いても良いし、又樹脂等を用いても良い。

## 【 0 0 5 0 】

図 8 は、研磨砥液（スラリ）を用いたポリッシング装置の構成例を模式的に示す。

この装置は、本発明の例えば A B S 樹脂等の熱可塑性樹脂を用いた研磨パッド 1 2 1 を貼付した研磨テーブル 5 4 ( 5 5 ) を備えている。研磨対象物である半導体ウエハ 1 0 4 を保持するトップリング 1 0 1 とを備え、トップリング 1 0 1 が半導体ウエハ 1 0 4 を研磨パッド 1 2 1 に押圧しつつ、両者が回転することにより半導体ウエハ 1 0 4 の被研磨面を摺動して研磨するものである。研磨パッド 1 2 1 上にはスラリ供給ライン 1 2 2 から研磨砥粒を多量に含むスラリ Q が供給される。半導体ウエハ 1 0 4 の被研磨面は、このように研磨砥粒を多量に含むスラリが分散された研磨パッド 1 2 1 に押圧しつつ摺動することで、その被研磨面の研磨が進行する。トップリング 1 0 1 は、ボールベアリング 1 1 1 を介して回転シャフト 1 0 8 に傾動自在に保持され、回転シャフト 1 0 8 の回転に伴い所定速度で回転する。半導体ウエハ 1 0 4 はトップリング周縁部に配置されたガイドリング 1 2 8 内に保持され、弾性膜 1 0 2 を介してトップリング 1 0 1 により研磨パッド 1 2 1 に対して押圧される。ここで、この研磨パッドは A B S 樹脂等の

熱可塑性樹脂が用いられているので、摺動時の温度上昇によりスクラッチ等を生じないソフトな研磨を行うことができる。また、樹脂成分に含まれる弾性要素を含む樹脂を用いることにより、マクロ的には硬く、ミクロ的には柔らかな高品位の研磨を行うことができる。

【 0 0 5 1 】

なお、上記各実施例は、本発明の好ましい実施例の一形態を述べたに過ぎず、本発明の趣旨を逸脱することなく、種々の変形実施例が可能なことは勿論である。

【 0 0 5 2 】

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、砥石または研磨パッドを構成する樹脂に、熱可塑性樹脂、または弾性要素を有する樹脂を用いることにより、良好な平坦性が得られると共に、スクラッチ（キズ）の少ない高品位の研磨を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施形態の砥石の構成例を模式的に示す図であり、（a）は熱可塑性樹脂を用いた場合であり、（b）は弾性体充填材を含む場合である。

【図 2】

射出成形の説明に付する図である。

【図 3】

本発明の実施形態の研磨パッドの構成例を模式的に示す図である。

【図 4】

本発明の実施形態の研磨パッドの他の構成例を模式的に示す。

【図 5】

ポリッシング装置の要部を示す図である。

【図 6】

クランプ方式により砥石工具を定盤に固定する固定方法を示す。

【図 7】

砥石工具を定盤に固定する他の固定方法を示す。



【図 8】

研磨砥液を用いたポリッシング装置の構成例を模式的に示す図である。

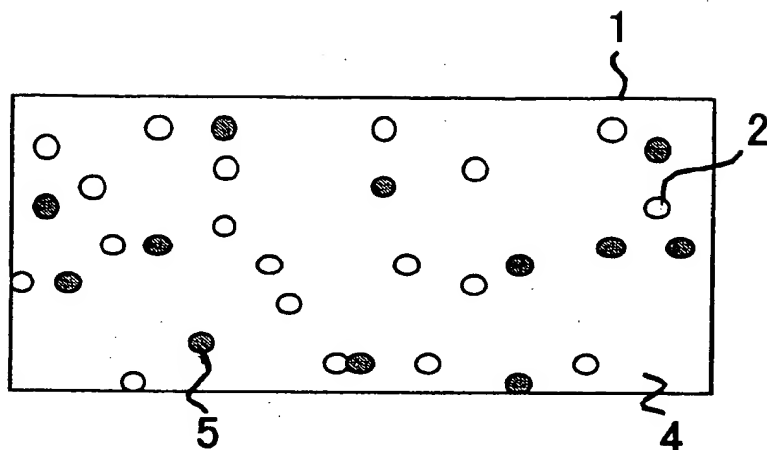
【符号の説明】

- 1     砥石
- 2     気孔または気孔剤
- 3     ゴム系粒子または中空粒子
- 4     バインダ
- 5     砥粒
- 1 1   射出油圧シリンダ
- 1 2   スクリュー回転用油圧モータ
- 1 3   ヒータ
- 1 4   逆流防止弁
- 1 5   金型
- 1 6   シリンダ
- 1 7   スクリュー
- 4 1   ゴム粒子または中空粒子
- 4 2   熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂
- 5 1   A B S 樹脂
- 5 2   弾性要素

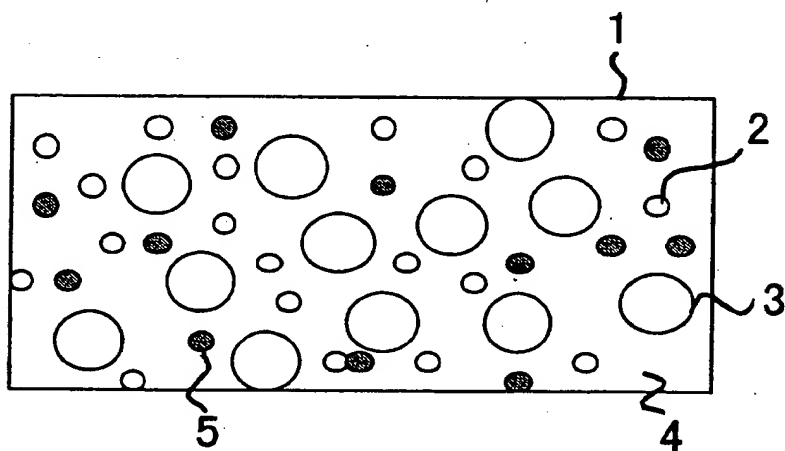
【書類名】 図面

【図 1】

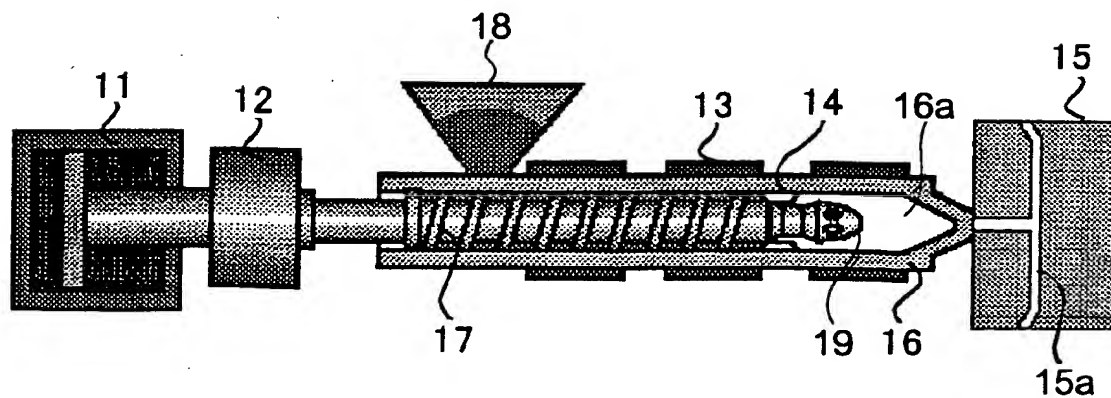
(a)



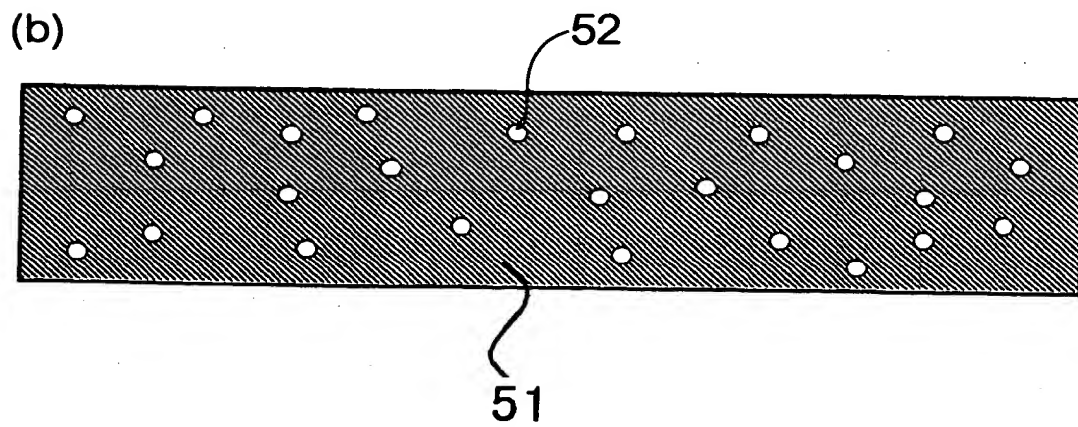
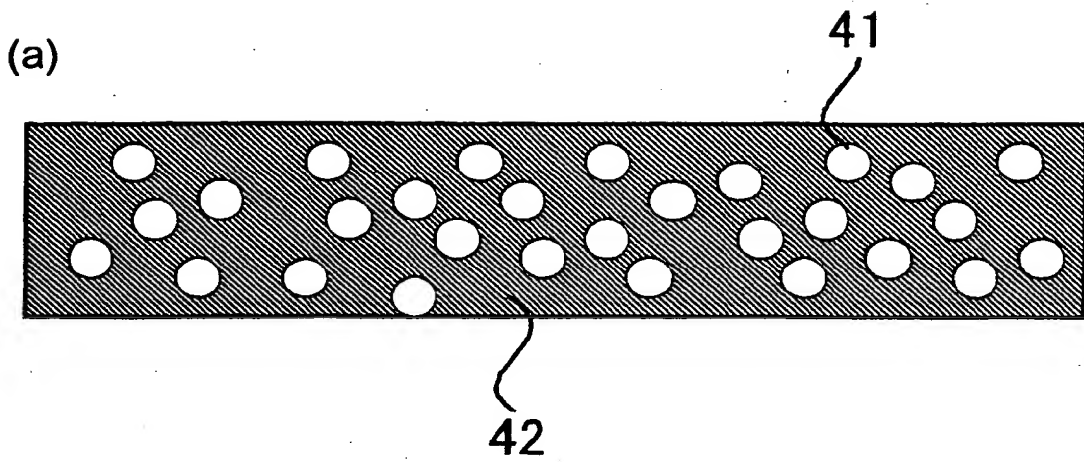
(b)



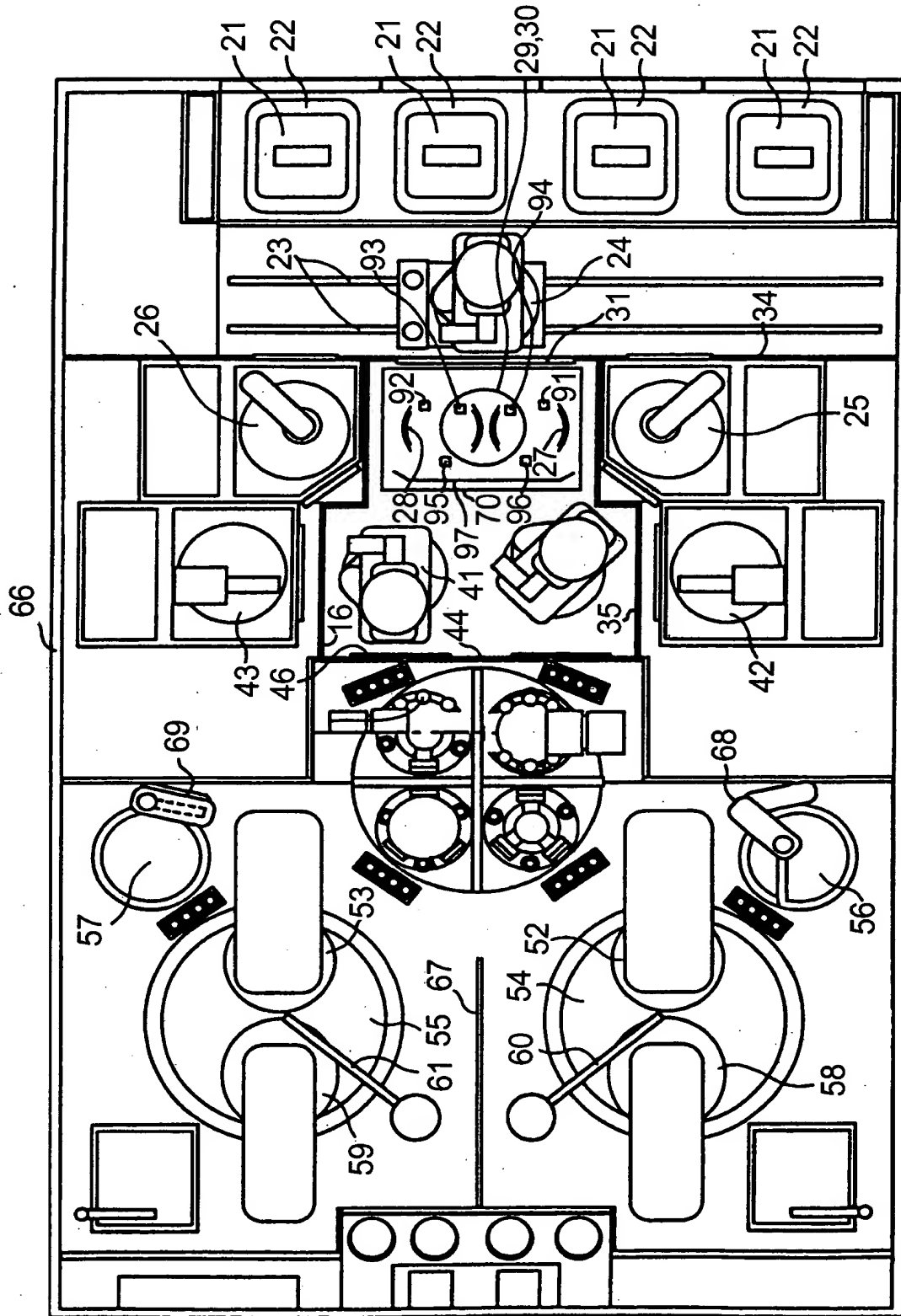
【図 2】



【図 3】

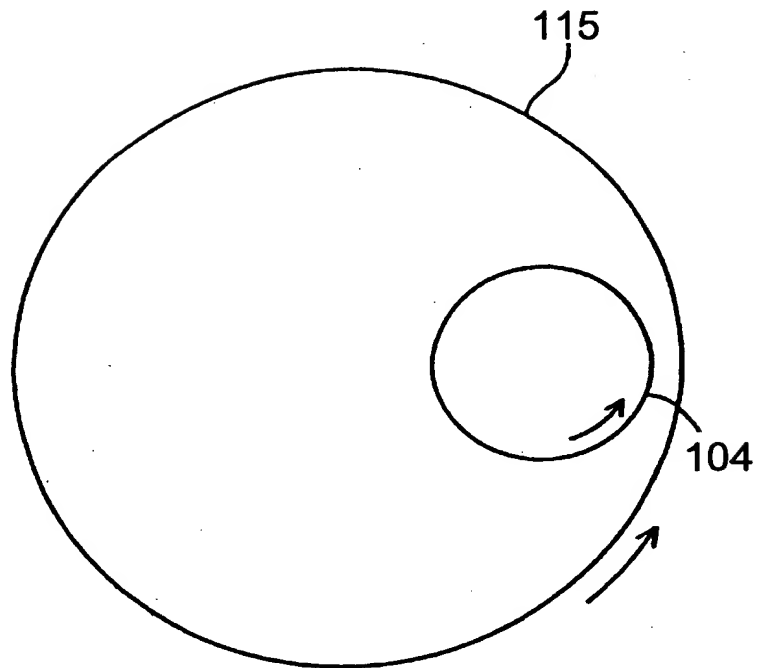


【図4】

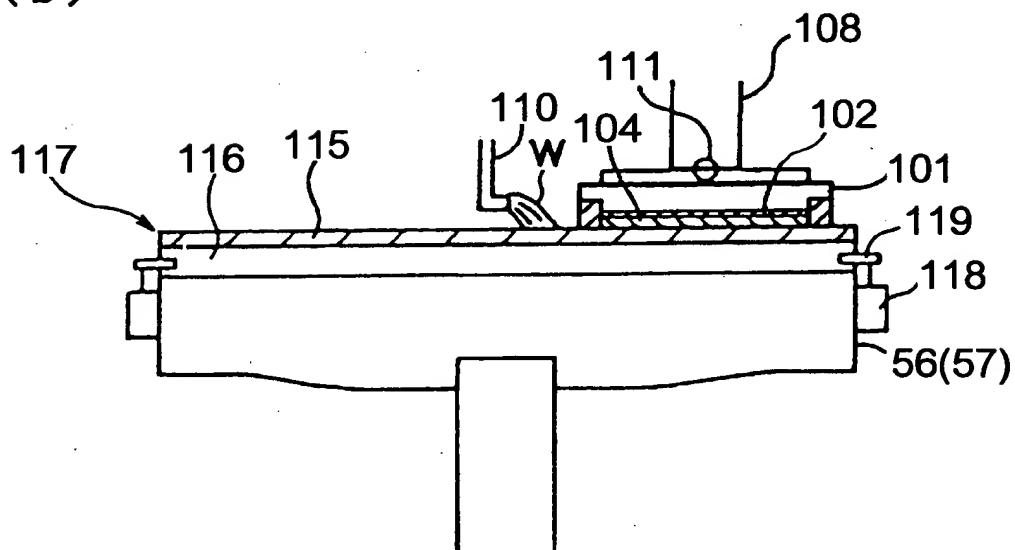


【図 5】

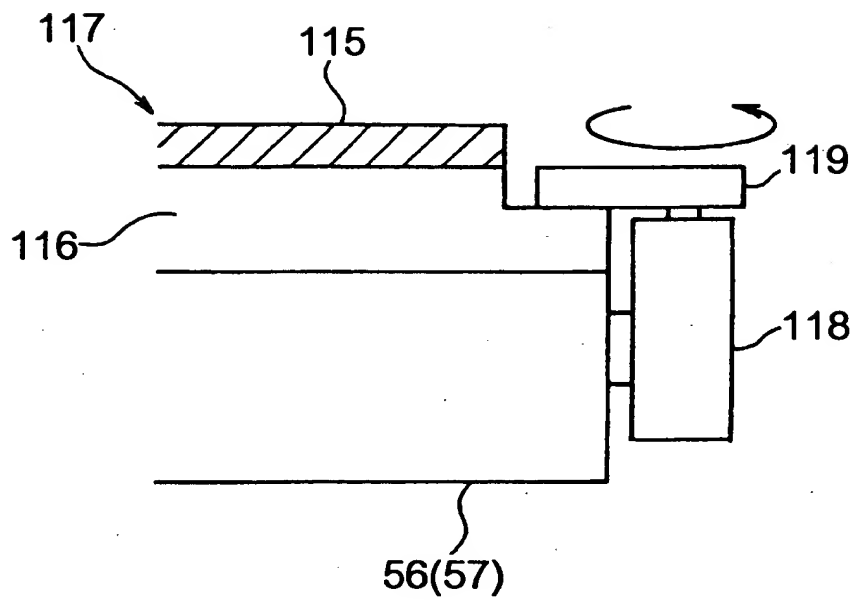
(a)



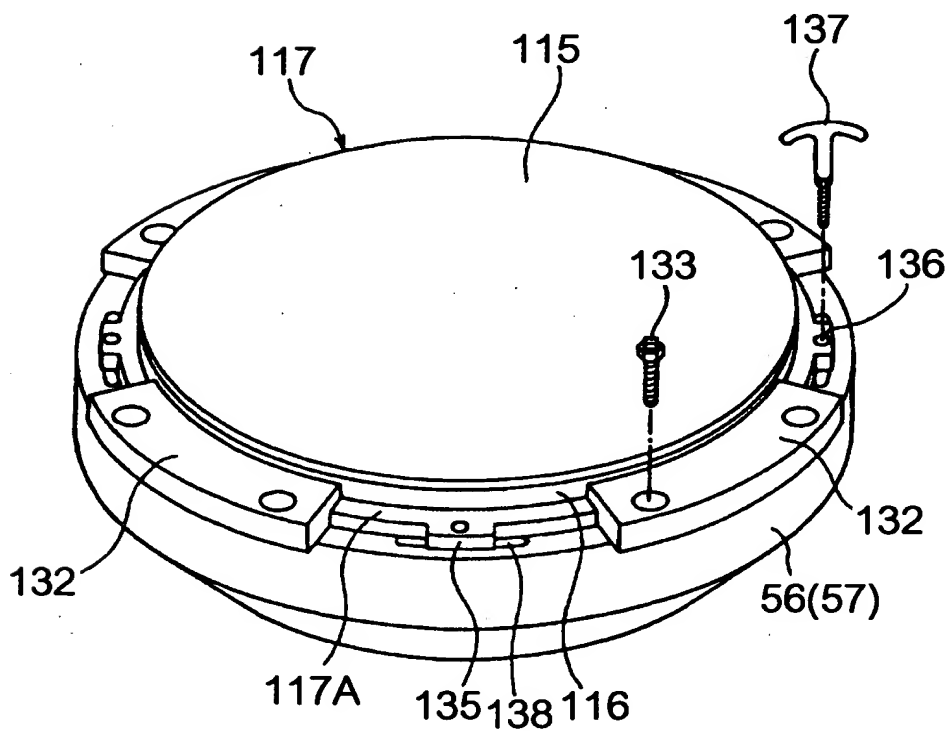
(b)



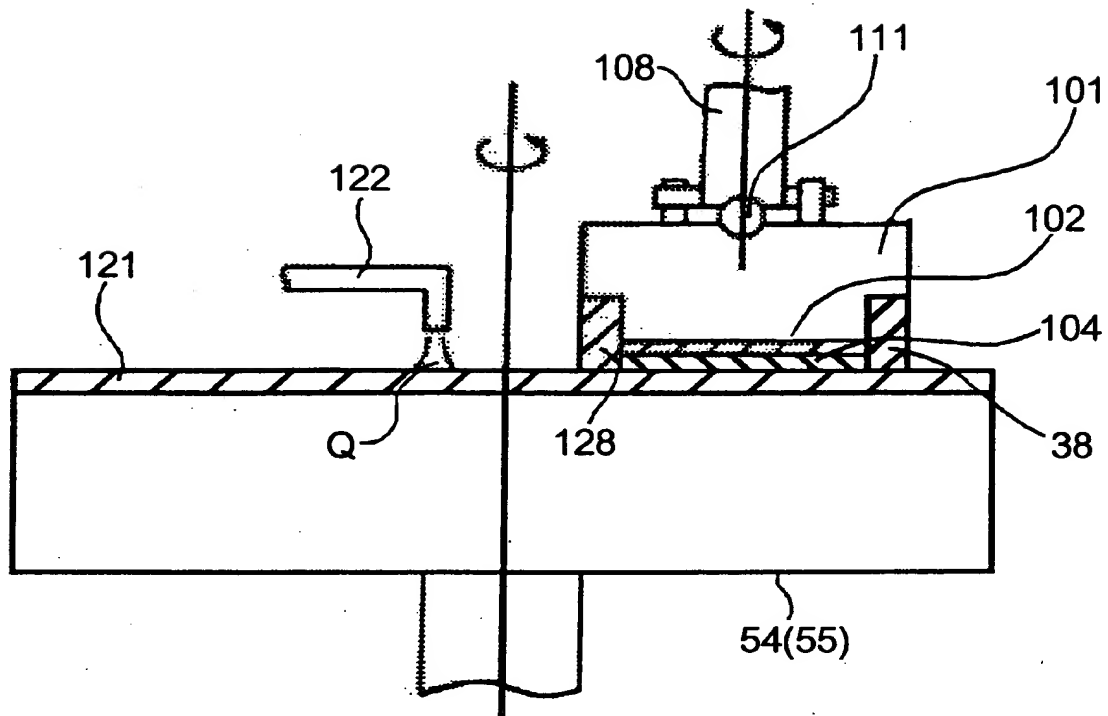
【図 6】



【図 7】



【図 8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 研磨速度の安定性、良好な段差特性が得られると共に、半導体ウェハの研磨対象物の研磨面に発生する欠陥（スクラッチ）の低減等を各種の研磨対象物に対して良好に発揮できる研磨部材を提供する。

【解決手段】 研磨対象物を押圧しつつ摺動することで、砥粒 5 を介して研磨を行う研磨工具において、該研磨工具は熱可塑性樹脂 4 により主として構成されている。

【選択図】 図 1



出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000000239]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区羽田旭町11番1号

氏 名 株式会社荏原製作所